

## Silicon Standard Recovery Diode

$V_{RRM} = 1600\text{ V} - 2000\text{ V}$   
 $I_F = 380\text{ A}$

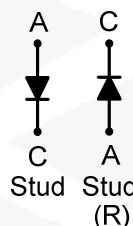
### Features

- High Surge Capability
- Types from 1600 V to 2000 V  $V_{RRM}$
- Not ESD Sensitive

### Note:

1. Standard polarity: Stud is cathode.
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
3. Stud is base.

DO-9 Package



### Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	S380Y (R)	S380Z (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		1600	2000	V
RMS reverse voltage	$V_{RMS}$		1131	1414	V
DC blocking voltage	$V_{DC}$		1600	2000	V
Continuous forward current	$I_F$	$T_C \leq 100\text{ }^\circ\text{C}$	380	380	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ , $t_p = 8.3\text{ ms}$	6335	6335	A
Operating temperature	$T_j$		-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$		-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

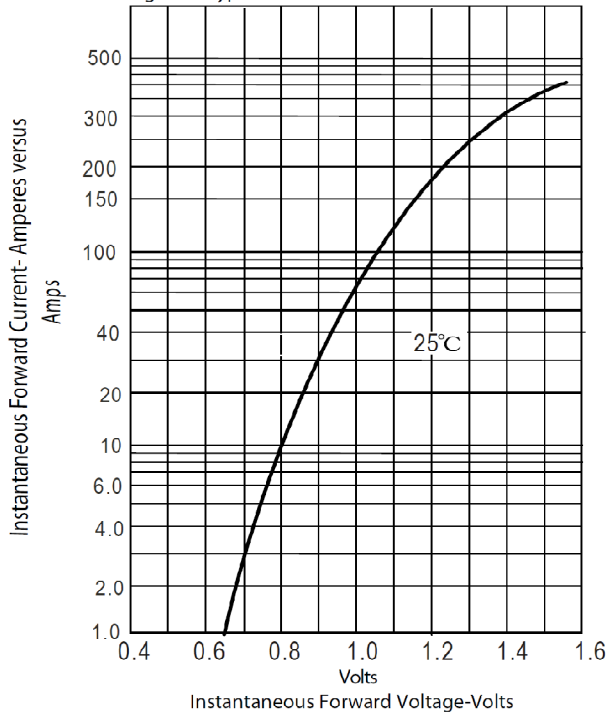
### Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	S380Y (R)	S380Z (R)	Unit
Diode forward voltage	$V_F$	$I_F = 380\text{ A}$ , $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.2	1.2	V
Reverse current	$I_R$	$V_R = 1600\text{ V}$ , $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	10	10	$\mu\text{A}$
		$V_R = 1600\text{ V}$ , $T_j = 175\text{ }^\circ\text{C}$	12	12	mA

### Thermal characteristics

Parameter	Symbol	Conditions	S380Y (R)	S380Z (R)	Unit
Thermal resistance, junction - case	$R_{thJC}$		0.16	0.16	$^\circ\text{C/W}$

Figure.1-Typical Forward Characteristics



Figur.2 Forward Derating Curve

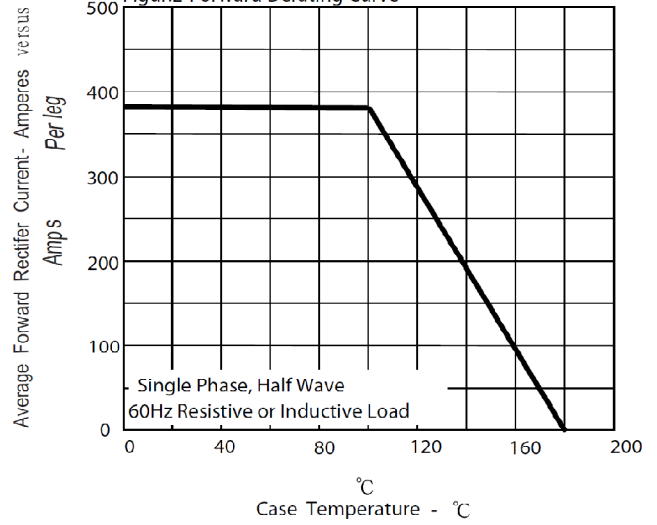
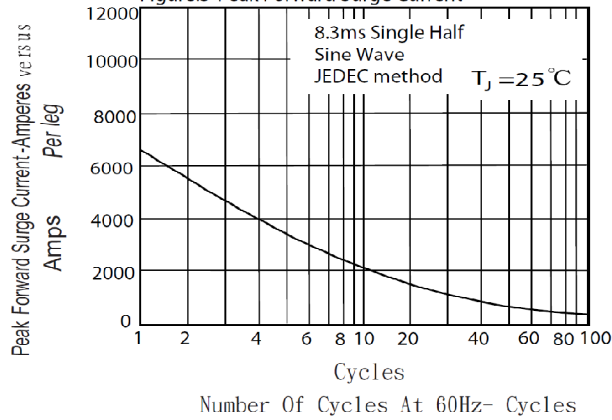
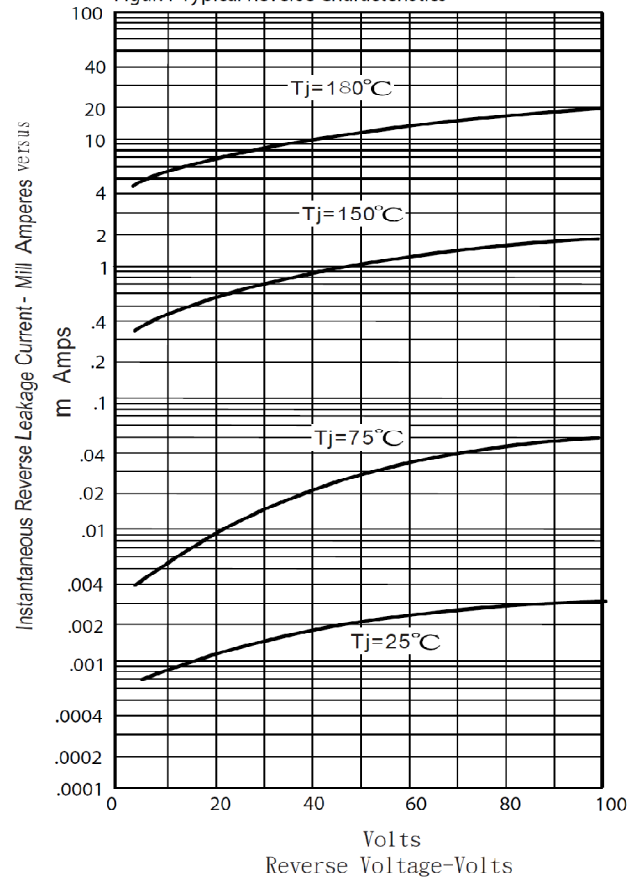


Figure.3-Peak Forward Surge Current

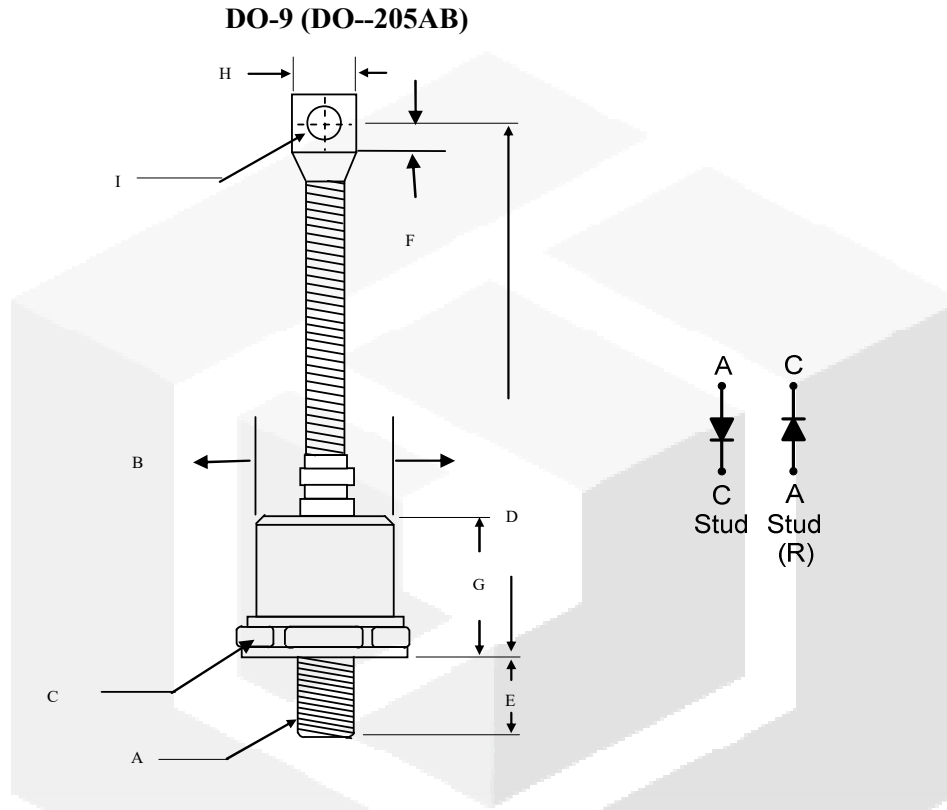


Figur.4-Typical Reverse Characteristics



**Package dimensions and terminal configuration**

Product is marked with part number and terminal configuration.



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	M 20 * P 1.5			
B	----	1.10	----	27.94
C	1.24	1.25	31.5	31.90
D	5.31	5.98	135	152
E	0.78	0.828	19.60	21.03
F	0.470	0.530	11.94	13.46
G	----	1.122	----	28.5
H	----	0.787	----	20.0
I	0.330	0.350	8.38	8.89

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[S380YR](#) [S380Z](#) [S380Y](#) [S380ZR](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.